半導体ナノロッドージアリールエテン誘導体ハイブリッド系の励起子 ダイナミクスと発光制御

¹関西学院大理工,²立教大理, 〇柴山大樹¹,上本健太¹,木下賢¹,碓井悠大¹,片山哲郎¹,森本正和², 入江正弘²,玉井尚登¹

Exciton Dynamics and Luminescence Control of the Hybrid System of Semiconductor Nanorods with Diarylethene Derivatives

 Daiki Shibayama¹, Kenta Uemoto¹, Ken Kinoshita¹, Yuta Usui¹, Tetsuro Katayama¹, Masakazu Morimoto², Masahiro Irie², Naoto Tamai¹
¹ Department of Chemistry, Kwansei Gakuin University, Japan
² Department of Chemistry and Research Center for Smart Molecules, Rikkyo University, Japan

[Abstract] Semiconductor nanorods (NRs) have large absorption cross section as compared with quantum dots (QDs), which is suitable to increase the efficiency of light absorption. On the other hand, diarylethene derivatives (DAE) exhibit photochromic reactions having various applications such as super-resolution microscopy. In the previous study, a hybrid nanostructure (HN) of CdSe/CdS/ZnS core/shell/shell QDs and DAE was constructed and luminescence switching of the system has been studied. However, semiconductor NRs have not been utilized for HNs until now. In the present study, we synthesized CdSe NRs by a colloidal synthetic method. Moreover, we constructed HNs of CdSe NRs - DAE with hydroxy group. It was found that luminescence of CdSe NRs was efficiently quenched by the closed isomer (DAEC) but not by the open isomer (DAEO). Exciton dynamics of these HNs and the mechanism of luminescence switching were examined by picosecond luminescence spectroscopy and femtosecond transient absorption spectrascopy.

【序】半導体ナノロッド (NRs) は量子ドットに比べ吸収断面積が大きく光の吸収量 が増加するだけでなく,長さ方向に量子閉じ込めの次元性が緩和しているという特 徴を有している.さらに近年では可視光を照射することで水分解を起こし,水素を発 生させる光触媒システムに NRs が用いられるなど注目を集めている.またジアリー ルエテン誘導体 (DAE) はフォトクロミック反応を示す典型的な化合物である.これ までに超解像利用を目指して DAE を CdSe/CdS/ZnS コア/シェル/シェル型量子ドット に吸着させた系の発光スイッチングは研究されているが,スイッチングの効率が悪い といった問題を抱えている[1].さらに,DAE と NRs を組み合わせた研究は,これま

で研究されていない.本研究では,NRsの特性を生かした光 応答システムの構築と高効率なスイッチング効率を目指し, ヒドロキシ基含有 DAE をコロイド合成した CdSe NRs に吸 着させ,ハイブリッド系の構築を行った.さらに,フォトク ロミック反応に伴う発光および励起子ダイナミクス の変化を時間分解レーザー分光法により解析した.ま た発光スイッチングのメカニズム解明を試みた.



Fig. 1. STEM image of CdSe NRs.

【方法 (実験・理論)】100℃で脱気した Cd 前駆体 [trioctylphosphine oxide (TOPO), tetradecylphosphonic acid (TDPA),酸化カドミウム]を320℃まで加熱し, TOP – Se を N₂雰囲気下でインジェクトし,250℃で 成長させた.その後試料を室温まで急冷し,メタノー ルを貧溶媒として加え遠心分離を行った.その沈殿物 を*n*-hexane 中に再度分散させ,CdSe NRs 分散液を得 た[2,3].この分散液に*n*-hexane には難溶解性で あるヒドロキシ基を置換基に持つ DAE を加えて 攪拌することでハイブリッド系を構築した.ハ イブリッド系の発光寿命はTi:Sapphire レーザー を励起光源 (λ_{ex} = 415 nm)としたピコ秒 singlephoton timing 法によって測定した.

【結果・考察】 合成した CdSe NRs の走 査型電子顕微鏡 (STEM) 像を Fig. 1 に 示す. この合成によって長軸 9.3 ± 0.5 nm, 短軸 3.9 ± 0.4 nm の NRs が得られ た. 次に合成した CdSe NRs-DAE 系の 吸収・発光スペクトルを Fig. 2 に示す. DAE の溶解度が極めて低い *n*-hexane 中 0 で閉環体の吸収スペクトルが観測でき たことから、DAE が CdSe NRs に吸着した と考えられる. また DAE の開環体 (DAEO) 状態では NRs の発光が殆ど消光 されなかったが、閉環体 (DAEC) 状態で は消光が観測された. DAEC の吸収スペク トルと CdSe NRs の発光スペクトルが大きく重な っており、この消光メカニズムは CdSe NRs から DAE への Förster 型励起エネルギー移動であるこ とを示唆している.次に CdSe NRs-DAE 系をスイ ッチングさせた時の各発光の強度比を Fig. 3a に, CdSe/CdS/ZnS コア/シェル/シェル型量子ドットで スイッチングを行った時の各発光の強度変化[1] を Fig. 3b に示す. ここから DAE の開環・閉環反 応が可逆的に起こっているため NRs の発光特性 の光スイッチングが可能であること,また NRs の

系においてより高効率なスイッチングが出来ているこ とが分かる.続いて消光メカニズムを明らかにするため



Fig. 2. Absorption and Luminescence spectra of CdSe NRs - DAEO (open isomer) and CdSe NRs - DAEC (closed isomer).



Fig. 3. (a)Repeatable switching of CdSe NRs-DAE (present study). (b)Repeatable switching of CdSe/CdS/ZnS core/shell/shell QDs (reference 1).



Fig. 4. Fluorescence lifetime spectrum of CdSe NRs-DAE.

蛍光寿命測定を行った結果を Fig.4 に示す. Poisson 統計を考慮した励起エネルギー移動の式[4]によりフィッティングを行った結果, CdSe NRs から DAEC へのエネルギー移動の時定数が約 770 ps と見積もられた.またこの時定数とフェルスターの式から CdSe NRs と DAE の距離を見積もったところ約 3 nm という結果が得られた.このこ とからもこの系では Förster 型励起エネルギー移動が起こっていると考えられる. 【参考文献】

- [1] Diaz, S.A.; Gillanders, F.; Jares-Erilman, E. A.; Jovin, T.M. Nat. Commun. 2015, 6, 6036-6047.
- [2] Wang, W.; Banerjee, S.; Jia, S.; Steigerwald, M.L.; Herman, I.P. Chem. Mater. 2007, 19, 2573-2580.
- [3] Flanagan, J.C.; Shim, M. J. Phys. Chem. C 2015, 119, 20162-20168.
- [4] Tachiya, M. J. Chem. Phys. 1982, 76, 340-348.